

BaCO₃-M₂O₃ 混合粉末 (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) から反応焼結により合成した BaM₂O₄ の秩序-無秩序転移

小林秀彦・荻野博幸・中村和正・森 利之*・山村 博*・三田村 孝

埼玉大学工学部応用化学科, 338 浦和市下大久保 255

*東ソー(株)筑波研究所, 305 つくば市御幸が丘 43

Order-Disorder Transition of BaM₂O₄ Bodies (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho or Y) Synthesized by Sintering of BaCO₃-M₂O₃ Mixtures

Hidehiko KOBAYASHI, Hiroyuki OGINO, Kazumasa NAKAMURA, Toshiyuki MORI*, Hiroshi YAMAMURA* and Takashi MITAMURA

Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Saitama University, 255, Shimo-ohkubo, Urawa-shi 338

*Tsukuba Laboratory, Tosoh Co., Ltd., 43, Miyukigaoka, Tsukuba-shi 305

[Received January 14, 1994; Accepted March 16, 1994]

Sintered bodies of BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho or Y) with CaFe₂O₄-related structure were synthesized by sintering BaCO₃-M₂O₃ mixtures. The temperature dependence of oxygen ionic conductivity and the relationship between the ionic radius of M³⁺ ions in B sites and the crystal structure of BaM₂O₄ were investigated. The ionic conductivity type in BaM₂O₄ was divided into two groups; (a) BaLa₂O₄, BaNd₂O₄ and BaSm₂O₄ with order-disorder transition and (b) BaGd₂O₄, BaHo₂O₄ and BaY₂O₄ without the transition. There were vacant spaces in the crystal structure of BaNd₂O₄ and BaSm₂O₄ with order-disorder transition due to the distortion in the α -axis direction of an oxygen octahedron. By assuming that the vacant space is an oxygen vacancy, the ionic conductivity in BaLa₂O₄, BaNd₂O₄ and BaSm₂O₄ has been explained with a model of the order-disorder transition for oxygen vacancies without significant shifting of cations in the crystal lattice.

Key-words : BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y), CaFe₂O₄ structure, Oxygen vacancy, Order-disorder transition, Ionic conductivity, Solid electrolyte

1. 緒 言

近年、ブラウンミラーライト構造に代表されるペロブスカイト関連構造を有する酸化物中の酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移が注目されている^{1)~4)}。著者らは、各種ペロブスカイト関連構造を有する Ba-M-O 系酸化物である BaLa₂O₄, Ba₃Y₄O₉, Ba₂In₂O₅ 及び Ba₃Ga₂O₆ の秩序-無秩序転移温度が B サイトに位置するカチオノン (M³⁺) 半径の増大に伴って低下することを明らかにした⁵⁾。これらの Ba-M-O 系酸化物の中でも転移温度が顕著に低い Ba₃Y₄O₉ の結晶構造⁶⁾及び CaFe₂O₄ 構造⁷⁾を有する BaLa₂O₄ 構造中には、ブラウンミラーライト構造に見られるような酸素イオン欠損タイプの典型である B サイトのカチオノンを中心とする酸素の四面体は存在しない。したがって、前述した転移現象をブラウンミラーライト構造の場合と同様に酸素の四面体の存在による酸素イオン空孔を用いて説明することはできない。

Maister と Lopato⁸⁾は CaFe₂O₄ 構造を有する BaY₂O₄ 及び BaLn₂O₄ (Ln : ランタノイド) を固相法により合成し、それらの密度、融点あるいは分解温度、格子定数等の物理的性質を詳細に調査している。しかしながら、これら一連の化合物の導電特性に関する報告はない。

そこで本研究では、CaFe₂O₄ 構造を有する BaLa₂O₄ と同じ結晶構造を持つ BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) 中の B サイトのカチオノン (M³⁺) を中心とする酸素の八面体の形状とカチオノン (M³⁺) 半径に着目し、まず反応焼結により単一相焼結体を合成してその酸素イオン導電率の温度変化を測定した。また、B サイトに位置するカチオノン (M³⁺) の半径と結晶構造の関連をリートベルト解析法を用いて定性的に調べた。そして、CaFe₂O₄ 構造を有する BaM₂O₄ の秩序-無秩序転移に伴う構造相転移について考察した。

2. 実験方法

出発原料には市販品粉末（純度 : 99.9%）の BaCO₃, La₂O₃, Nd₂O₃, Sm₂O₃, Gd₂O₃, Ho₂O₃ 及び Y₂O₃ を用いた。各粉末を所定比に秤量して調整した粉末をプラスチック製ポットと Al₂O₃ ボールを用いたボールミルでエタノールを溶媒として 24h 湿式混合した後、十分に乾燥させた。各混合粉末を一軸加圧 (98 MPa) 成形した後、Ar ガス流通下において室温～1173 K まで 20 K/min, 1173 K から 1573 K あるいは 1673 K まで 4 K/min で昇温させて 4h 保持して焼結体を作製した。

結晶相の同定及び Si (純度 : 99.9%) を外部標準物質とした格子定数の測定は、作製した焼結体を十分に粉碎して粉末 X 線回折試験 (Cu K α , 40 kV, 30 mA) により行った。一部の試料については、リートベルト解析プログラム (RIETAN⁹⁾) を用いて結晶構造パラメーターを精密化した。この際には $20^\circ \leq 2\theta \leq 80^\circ$ の範囲の粉末 X 線回折パターン (Cu K α , 45 kV, 300 mA) を用い、表 1 に示す CaFe₂O₄ の原子座標⁷⁾を初期値とした。また、四つの同価位置の酸素の熱振動パラメーターは同じ値となるようにし

Table 1. Crystal Data and Atomic Parameter of CaFe₂O₄⁷⁾

D_{2h}¹⁶ - Pnam, a=0.9230nm, b=1.0705nm, c=0.3024nm, Z=4
site : 4c : x, y, 1/4 ; -x, -y, 3/4 ; 1/2-x, 1/2+y, 3/4
; 1/2+x, 1/2-y, 1/4

atom	x	y
Ca	0.756	0.654
Fe(1)	0.433	0.610
Fe(2)	0.420	0.108
O (1)	0.208	0.162
O (2)	0.115	0.477
O (3)	0.521	0.784
O (4)	0.419	0.424

た。

作製した焼結体のイオン導電率は、厚さ約2mmの焼結体の両面にPtペーストを塗布してArガス流通下で1123K, 15min焼き付けた後、赤外加熱炉を用いてArガス流通下、473~1173Kの温度範囲で交流二端子法(周波数: 1kHz)により測定した。

3. 実験結果及び考察

3.1 反応焼結による BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) の合成

CaFe₂O₄構造を有するBaM₂O₄(M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y)の単一相焼結体の合成条件を反応焼結を用いて調べた。この際には、Ba₃M₄O₉相が生成しないよう MaisterとLopatoのBaY₂O₄及びBaLn₂O₄の分解温度⁸⁾を参考にし、また合成時の降温過程でBaM₂O₄が大気中の水分により分解するのを防ぐため、合成雰囲気はArガス流通下とした。

図1に合成した単一相のBaM₂O₄(M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y)焼結体のX線回折パターンをまとめて示す。La以外のBaM₂O₄の単一相焼結体は化学量論組成の混合粉末を用いて1573Kで4hの反応焼結により合成できた。BaNd₂O₄焼結体の表面にはトレース程度のNd₂O₃相が同定されたが、ほぼ単一相であった。これに対して、BaLa₂O₄

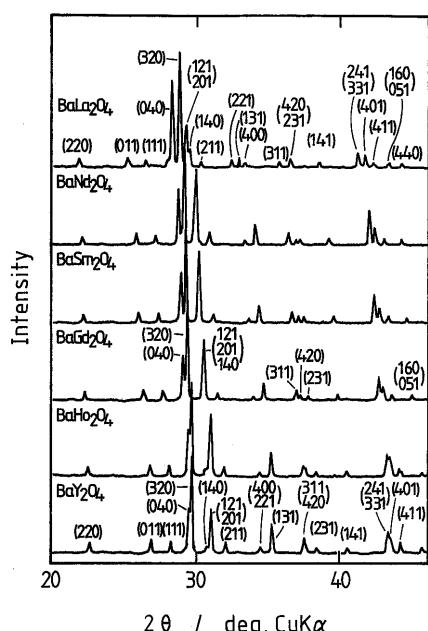


Fig. 1. X-ray diffraction patterns of BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) synthesized by reaction sintering.

焼結体の合成では合成時にBaOの揮発が著しく、化学量論組成よりも過剰量のBaCO₃を必要とするため、Ba/La原子比=1の混合粉末を用いて1673Kで4h反応焼結させることによって単一相とした⁵⁾。

合成した各単一相焼結体のX線回折パターンは、図1に示したように斜方晶系のCaFe₂O₄構造として指数付けでき、合成したBaM₂O₄の格子定数はMaisterとLopatoの結果⁸⁾とほぼ一致していた。

3.2 BaM₂O₄焼結体の酸素イオン導電率の温度依存性

合成したBaM₂O₄(M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y)焼結体の酸素イオン導電率の温度依存性を調べ、その導電特性に及ぼすBサイトのカチオニン(M³⁺)半径の影響を検討した。

図2にBaM₂O₄(M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y)焼結体のイオン導電率の温度依存性をまとめて示す。測定したBaM₂O₄焼結体の導電特性はBサイトのカチオニン種により、秩序-無秩序転移を伴うBaLa₂O₄, BaNd₂O₄及びBaSm₂O₄焼結体と転移を伴わないBaGd₂O₄, BaHo₂O₄及びBaY₂O₄焼結体のグループに大別された。特に、秩序-無秩序転移を伴わないグループの導電率は1073Kでも10⁻³S/m程度と顕著に低かった。

表2にBaLa₂O₄, BaNd₂O₄及びBaSm₂O₄焼結体の転移温度及び転移前後のイオン導電率の活性化エネルギーとBaGd₂O₄, BaHo₂O₄及びBaY₂O₄焼結体のイオン導電率の

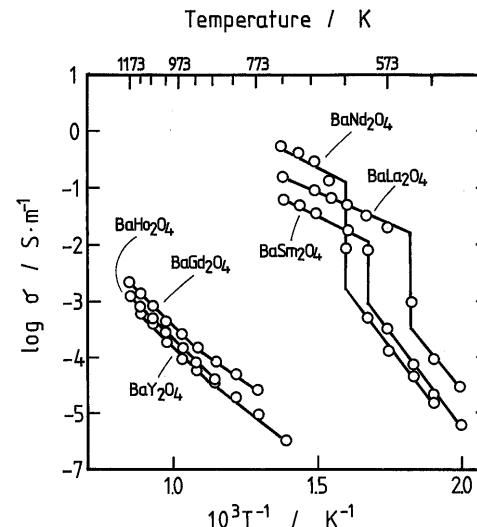


Fig. 2. Temperature - dependence of the conductivity of BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) sintered bodies.

Table 2. Activation Energies of Conductivity and Transition Temperatures of BaM₂O₄ (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y)

	Activation energy (kJ/mol) before transition	Activation energy (kJ/mol) after transition	Transition temperature (K)
BaLa ₂ O ₄	122	54	543
BaNd ₂ O ₄	133	49	623
BaSm ₂ O ₄	138	53	603
BaGd ₂ O ₄		99	—
BaHo ₂ O ₄		107	—
BaY ₂ O ₄		87	—

活性化エネルギーをまとめ示す。 BaLa_2O_4 , BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 焼結体の転移温度は 543~623 K の範囲にあり、転移前後の導電率の活性化エネルギーは 122~138 kJ/mol と 49~54 kJ/mol で、プラウンミラーライト構造を有する $\text{Ba}_2\text{In}_2\text{O}_5$ の転移前後の活性化エネルギーの 132 kJ/mol⁵⁾ と 59 kJ/mol⁵⁾ とほぼ一致していた。一方、転移を伴わない BaGd_2O_4 , BaHo_2O_4 及び BaY_2O_4 焼結体の導電率の活性化エネルギーは 87~107 kJ/mol であった。

3.3 BaM_2O_4 の結晶構造に及ぼすカチオン (M^{3+}) 半径の影響

合成した BaM_2O_4 (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) の格子定数 (a , b , c 軸) を用い、 BaY_2O_4 の格子定数を基準にした場合の BaM_2O_4 の格子定数の変化率と B サイトのカチオン (M^{3+}) 半径の関係を調べた。その結果を図 3 に示す。なお、図中には Maister と Lopato の BaY_2O_4 と BaLn_2O_4 (Ln : ランタノイド) の格子定数⁸⁾ から同様に算出した値も示した。 BaM_2O_4 の B サイトに位置するカチオン (M^{3+}) 半径の増大に伴って b 軸と c 軸の格子定数の変化率はほぼ直線的に増加しているが、 a 軸の格子定数の変化率は Sm³⁺ のイオン半径付近に変曲点を有することから、 BaLa_2O_4 , BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 の結晶構造は a 軸方向の変位を内在していると考えられる。この B サイトのカチオン (M^{3+}) 半径と格子定数の変化率の関係は、3.2節に既述した BaM_2O_4 焼結体の導電特性のカチオン (M^{3+}) 種によるグループ分けと一致していた。

そこで、合成した BaM_2O_4 (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) の結晶構造に及ぼすカチオン (M^{3+}) 半径の影響を明らかにするために、リートベルト解析法を用いて BaNd_2O_4 , BaSm_2O_4 , BaGd_2O_4 及び BaY_2O_4 の結晶構造を精密化した⁹⁾。表 3 に精密化した構造パラメーターを示す。なお、席占有率は各同価位置 (Ba, M(1), M(2), O(1), O(2),

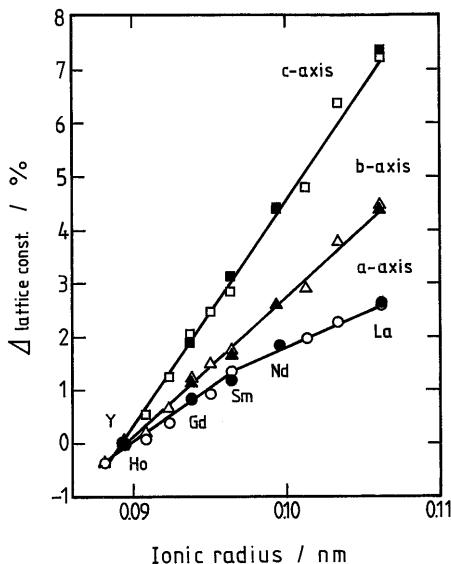


Fig. 3. Relationship between the changing rate in lattice constant of BaM_2O_4 (M : La, Nd, Sm, Gd, Ho, Y) and the ionic radius of M^{3+} ion.

●, ▲, ■: experimental data,
○, △, □: reference data.⁸⁾

Table 3. Structural Parameters and Lattice Constants by X-ray Rietveld Refinement for BaM_2O_4 (M : Nd, Sm, Gd, Y)
The Number in Parenthesis is e.s.d.'s. referred to Last Digit

BaY_2O_4				
$a=1.03936(1)\text{nm}, b=1.21142(2)\text{nm}, c=0.344996(5)\text{nm}$				
atom	site	x	y	z
Ba		0.7523(5)	0.6486(4)	0.6(1)
Y(1)		0.4260(7)	0.6114(4)	0.5(2)
Y(2)		0.4221(7)	0.1093(5)	0.5(2)
O(1)	4c	0.205(3)	0.164(4)	0.25
O(2)		0.115(4)	0.486(4)	0.1(7)
O(3)		0.525(5)	0.790(3)	0.1(7)
O(4)		0.427(4)	0.425(3)	0.1(7)

$R_{wp}=10.14\%$, $R_F=7.81\%$, $R_E=3.10\%$, $R_I=4.38\%$, $R_F=2.08\%$

BaGd_2O_4				
$a=1.04857(2)\text{nm}, b=1.22610(2)\text{nm}, c=0.351420(6)\text{nm}$				
atom	site	x	y	z
Ba		0.7507(8)	0.6488(7)	0.9(2)
Gd(1)		0.4235(8)	0.6122(6)	1.3(2)
Gd(2)		0.4223(8)	0.1100(6)	0.7(2)
O(1)	4c	0.207(3)	0.162(4)	0.25
O(2)		0.117(5)	0.487(5)	0.8(11)
O(3)		0.529(6)	0.786(5)	0.8(11)
O(4)		0.426(6)	0.423(4)	0.8(11)

$R_{wp}=9.53\%$, $R_F=7.28\%$, $R_E=3.96\%$, $R_I=3.96\%$, $R_F=3.36\%$

BaSm_2O_4				
$a=1.05124(2)\text{nm}, b=1.23307(3)\text{nm}, c=0.355960(7)\text{nm}$				
atom	site	x	y	z
Ba		0.7505(10)	0.6479(9)	0.5(2)
Sm(1)		0.4225(10)	0.6121(7)	0.6(3)
Sm(2)		0.4220(10)	0.1110(7)	0.2(3)
O(1)	4c	0.204(7)	0.171(6)	0.25
O(2)		0.120(7)	0.488(7)	0.3(14)
O(3)		0.527(8)	0.784(6)	0.3(14)
O(4)		0.442(8)	0.427(6)	0.3(14)

$R_{wp}=10.76\%$, $R_F=8.52\%$, $R_E=4.34\%$, $R_I=7.44\%$, $R_F=5.32\%$

BaNd_2O_4				
$a=1.05863(3)\text{nm}, b=1.24408(4)\text{nm}, c=0.360250(9)\text{nm}$				
atom	site	x	y	z
Ba		0.7499(10)	0.6467(8)	0.7(2)
Nd(1)		0.4194(11)	0.6126(7)	1.4(3)
Nd(2)		0.4235(11)	0.1128(7)	0.4(3)
O(1)	4c	0.205(7)	0.169(6)	0.25
O(2)		0.121(6)	0.484(6)	0.6(14)
O(3)		0.524(8)	0.788(6)	0.6(14)
O(4)		0.446(8)	0.415(6)	0.6(14)

$R_{wp}=10.07\%$, $R_F=7.81\%$, $R_E=3.99\%$, $R_I=6.42\%$, $R_F=4.80\%$

O(3), O(4))に対してすべて 1 とした。また、図 4 に精密化した構造パラメーターを用いた BaNd_2O_4 , BaSm_2O_4 , BaGd_2O_4 及び BaY_2O_4 の c 軸方向から投影した結晶構造を示す。 CaFe_2O_4 構造は稜を共有した二つの八面体を基本単位とする網目構造であり、 BaNd_2O_4 と BaSm_2O_4 の結晶構造は BaGd_2O_4 あるいは BaY_2O_4 の結晶構造に比べて、表 3 に示した O(4) 位置の酸素イオンの a 軸方向の変位により B サイトのカチオン (M^{3+}) を中心とする酸素の八面体の一部に歪を有している。この BaNd_2O_4 と BaSm_2O_4 では 147° 程度、 BaGd_2O_4 及び BaY_2O_4 では 154° 程度であり、 BaGd_2O_4 と BaY_2O_4 の結晶構造より 4.5% 程度増加していた。この歪により BaNd_2O_4 と BaSm_2O_4 の結晶構造中には空隙が導入される。すなわち、酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移を伴う BaLa_2O_4 , BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 焼結体の高い酸素イオン導電率は、八面体の a 軸方向の歪で生成した空隙と密

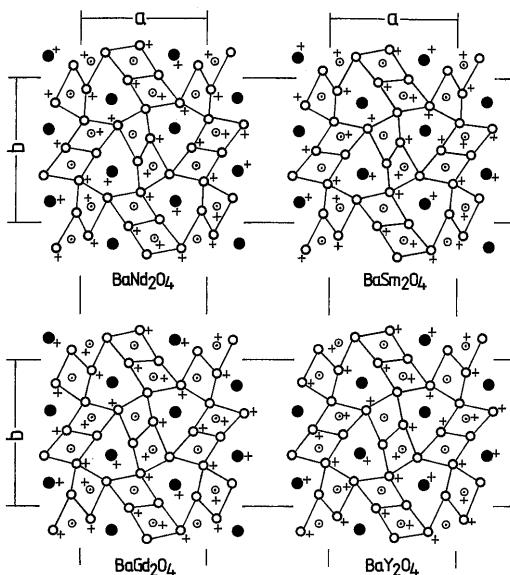


Fig. 4. Projection on the (001) plane of the crystal structure of BaM_2O_4 ($\text{M} : \text{Nd}, \text{Sm}, \text{Gd}, \text{Y}$) by X-ray Rietveld refinement. All atoms are located the planes $z=1/4$ or $3/4$.

● : Ba, ○ : O, ⊙ : M

接に関係していることになる。

3.4 BaM_2O_4 の酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移モデル

CaFe_2O_4 構造中にはブラウンミラーライト構造に見られる典型的な酸素イオン空孔は存在しないが、3.3節に既述したように、 BaM_2O_4 の B サイトのカチオン (M^{3+}) 半径の増大により BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 の結晶構造中には、酸素の八面体の a 軸方向の歪に伴う空隙が存在する。この空隙（サイト）に酸素イオンが存在できると仮定すると、このサイトは酸素イオン空孔と見なせるため、結晶格子のカチオンの大きな移動を伴わない酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移を考えることができる。一例として、図 5 に BaNd_2O_4 の結晶構造中に存在する空隙（酸素イオン空孔）を破線の丸印で示す。単位格子中の 20 個のサイトに対して、16 個の酸素イオンは転移前では規則（秩序）的に存在しているが、転移後では不規則（無秩序）化する。この秩序-無秩序転移により BaNd_2O_4 の酸素イオン導電率は温度に対して不連続性を示すことになる。したがって、図 2 に示した BaLa_2O_4 , BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 焼結体のイオン導電率の温度依存性は酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移を用いることで説明でき、この際の転移温度は低くなる。

以上をまとめると、提案した BaM_2O_4 における酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移モデルは、 BaM_2O_4 構造中の B サイトのカチオン (M^{3+}) 半径の増大により酸素イオンで構成される八面体の a 軸方向の歪で導入される空隙を取り扱っている。

BaM_2O_4 の導電機構は、ブラウンミラーライト構造における四面体の存在による空隙（酸素イオン空孔）と同様に、結晶構造内に八面体の歪による空隙を考えることにより酸素イオン空孔を利用した秩序-無秩序転移を伴う酸素イオン導電機構であると推察される。

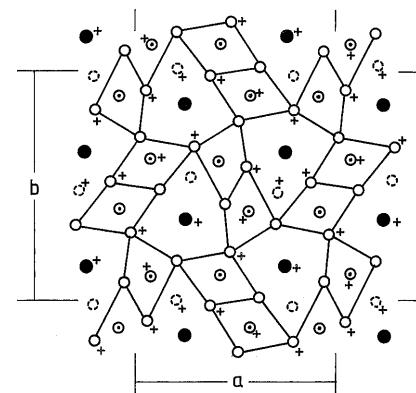


Fig. 5. Location of oxygen vacancies in the structure of BaNd_2O_4 . ● : Ba, ○ : O, ⊙ : Nd, ○- : oxygen vacancy.

4. 結 言

反応焼結により CaFe_2O_4 構造を有する BaM_2O_4 ($\text{M} : \text{La}, \text{Nd}, \text{Sm}, \text{Gd}, \text{Ho}, \text{Y}$) の単一相焼結体を合成し、その酸素イオン導電率の温度依存性及び結晶構造と B サイトのカチオン (M^{3+}) 半径の関係を調べ、次のような知見を得た。

(1) 合成した BaM_2O_4 焼結体の酸素イオン導電特性はカチオン (M^{3+}) 種により、秩序-無秩序転移を伴う BaLa_2O_4 , BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 焼結体と転移を伴わない BaGd_2O_4 , BaHo_2O_4 及び BaY_2O_4 焼結体のグループに大別された。

(2) BaM_2O_4 の B サイトのカチオン (M^{3+}) 半径の増大に伴って b 軸と c 軸の格子定数の変化率はほぼ直線的に増加したが、 a 軸の格子定数の変化率は Sm^{3+} のイオン半径に相当するところに変曲点を持っていた。

(3) 秩序-無秩序転移を有する BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 の結晶構造中には、酸素イオンで構成される八面体の a 軸方向の歪に起因する空隙が存在していた。

(4) BaLa_2O_4 , BaNd_2O_4 及び BaSm_2O_4 焼結体の酸素イオン導電率の温度依存性は、結晶構造中の八面体の a 軸方向の歪に伴う空隙（サイト）に酸素イオンが存在できる（酸素イオン空孔）と仮定すると、結晶格子のカチオンの大きな移動を伴わない低温での酸素イオン空孔の秩序-無秩序転移モデルにより説明できる。

文 献

- 1) B. C. H. Steele, *Mater. Sci. Eng.*, B13, 79-87 (1992).
- 2) 荒井弘通, セラミックス, 27, 100-04 (1992).
- 3) D. M. Smith, *Ann. Rev. Mater. Sci.*, 15, 329-57 (1985).
- 4) J. B. Goodenough and Y. S. Zhen, *Mater. Res. Soc. Symp. Proc.*, 210, 287-301 (1991).
- 5) T. Mitamura, H. Ogino, H. Kobayashi, T. Mori and H. Yamamuro, *J. Am. Ceram. Soc.*, 76, 2127-28 (1993).
- 6) Hk. Muller-Buschbaum and O. Sohren, *J. Alloy. Comp.*, 191, 151-54 (1993).
- 7) B. F. Decker and J. S. Kasper, *Acta Crystallogr.*, 10, 332-37 (1957).
- 8) N. M. Maister and I. M. Lopato, *Inorg. Mater.*, 9, 57-60 (1973).
- 9) 泉 富士夫, 日本結晶学会誌, 27, 23-31 (1985).